

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
научного сотрудника
в лаб. физики полупроводниковых гетероструктур.
Вакансия VAC 137485

Тематика исследований

Разработка технологических процессов создания полупроводниковых излучателей и приемников оптического излучения, исследования структурных, оптических и электрических свойств гетероструктур в системе материалов In-Al-Ga-As-P.

Трудовая деятельность

- Участие в научных исследованиях и разработках источников оптического излучения на основе полупроводниковых гетероструктур пониженной размерности в системах материалов InAlGaAs/GaAs и InAlGaAs/InP в составе коллектива лаборатории физики полупроводниковых гетероструктур.
- Планирование и проведение экспериментальных исследований с последующим анализом результатов определения параметров многослойных полупроводниковых гетероструктур методом рентгеновской дифрактометрии и рефлектометрии, оптической рефлектометрии и спектральной эллипсометрии.
- Исследование мощностных, спектральных и СВЧ-характеристик лазерных диодов с оптическими микрорезонаторами.
- Участие в подготовке статей для публикаций в рецензируемых научных журналах и представления полученных результатов на российских и международных конференциях
- Участие в подготовке отчетов по проектам фундаментальных и прикладных исследований, написании заявок на выдачу патента.
- Участие в конкурсах научно-исследовательских проектов.
- Руководство работами по выполнению научно-исследовательских проектов.

Требования к кандидату

- высшее профессиональное образование;
- наличие ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности -физика полупроводников или смежной;
- стаж научной деятельности по специальности не менее 15 лет;
- опыт исследовательской работы в области неразрушающей диагностики параметров многослойных полупроводниковых гетероструктур рентгеновским и оптическими методами;
- опыт исследовательской работы в области лазерных излучателей с вертикальными оптическими микрорезонаторами;
- опыт участия в научных грантах, научно-исследовательских и/или опытно конструкторских работах в качестве руководителя и исполнителя;
- число научных публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования Scopus, Web of Science, за последние 5 лет – не менее 22, в том числе наличие среди них публикаций в высокорейтинговых журналах, входящих в квартили Q1или Q2;
- наличие патента на изобретение или полезную модель в области оптоэлектронных приборов;
- Индекс Хирша (по версии Web of Science/Scopus) не ниже 8.

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 40 800 руб.

СТАВКА: 1.0

Срок трудового договора – 5 лет

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- ☐ копии документов о высшем профессиональном образовании;
- ☐ копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- ☐ сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.